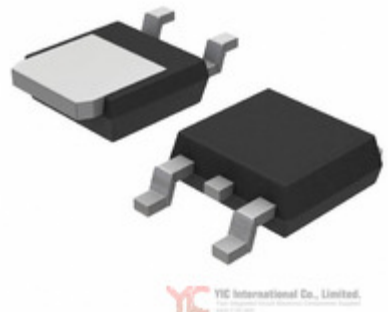



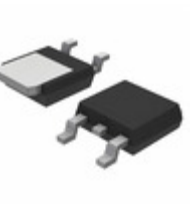





	<h2 style="color: red;">FDD86367</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDD86367</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CHANNEL 80V 100A TO252
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDD86367.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDD86367
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CHANNEL 80V 100A TO252
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.2 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	227W (Tj)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FDD86367OSCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4840pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	88nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 100A (Tc) 227W (Tj) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

FDD86367 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD86367-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD86367 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDD86367 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDD86252</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 5A DPAK</p>	 <p><b>FDD86367-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 100A DPAK</p>	 <p><b>FDD86369</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CHANNEL 80V 90A TO252</p>	 <p><b>FDD86326</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V TRENCH DPAK</p>
 <p><b>FDD86252</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 5A DPAK</p>	 <p><b>FDD86369-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 90A DPAK</p>	 <p><b>FDD86367_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 100A DPAK</p>	 <p><b>FDD86326</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V TRENCH DPAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDD86367 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDD86367 Datenblatt	FDD86367-Datenblätter	FDD86367 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD86367
FDD86367 Electronic	FDD86367-Komponenten	FDD86367-Verteiler	FDD86367-Bild	FDD86367-Teil
FDD86367 Preis	FDD86367 Hersteller	FDD86367 Bild	FDD86367 Aktie	FDD86367 Inventar
FDD86367 Neu	FDD86367 Original	FDD86367 garantiert	FDD86367 RFQ	FDD86367 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited